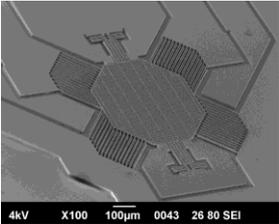


(様式 1)

1. 研究者	土屋智由
2. 研究者 DB 等	<a href="http://researchmap.jp/read0192569">http://researchmap.jp/read0192569</a>
3. 所属	京都大学 大学院/工学研究科/マイクロエンジニアリング専攻
4. 研究テーマ	ナノテクノロジーハブ拠点を活用したシリコン静電容量型 MEMS デバイスの高機能化
5. 利用可能な施設・装置等	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"></div> <p style="text-align: center;">ナノハブ・クリーンルーム                      試作した光チョッパ</p> <p>【主なプロセス装置】超高速 EB 描画装置、誘導結合プラズマ(ICP)エッチング装置、ウエハ接合装置、犠牲層エッチング装置、ステルスダイシング装置 他</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"></div> <p style="text-align: center;">超高速 EB 描画装置                      ステルスダイシング装置</p> <p>【主な分析装置】マイクロシステムアナライザ (MEMS 変位計測装置), 真空プローバ, 走査型プローブ顕微鏡, インピーダンスアナライザ, 半導体パラメータアナライザ 他</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"></div> <p style="text-align: center;">MEMS 変位計測装置                      真空プローバ                      計測装置</p>
6. 研究室等 HP	<a href="http://www.nms.me.kyoto-u.ac.jp/member/tsuchiya.html">http://www.nms.me.kyoto-u.ac.jp/member/tsuchiya.html</a>
7. E-MAIL	tutti@me.kyoto-u.ac.jp
8. TEL	075-383-3691
9. 特記事項	京大ナノハブ拠点到設置されている超高速電子線描画装置, i 線ステップ, ICP-RIE, 犠牲層ドライエッチング装置, ウエハ接合装置, ステルスダイシング装置, 各種 MEMS 評価機器などを活用して、シリコン MEMS デバイスの作製, 特に静電容量型デバイスの研究を推進。